

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	JPO-PAS 0321
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	TU04-1005W01
I	発明の名称	高純度ハフニウム、同高純度ハフニウムからなるターゲット及び薄膜並びに高純度ハフニウムの製造方法
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	株式会社 日鉱マテリアルズ
II-4en	Name:	Nikko Materials Co., Ltd.
II-5ja	あて名	1050001 日本国
II-5en	Address:	東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050001 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	03-5573-6564
II-9	ファクシミリ番号	03-5573-6779
II-11	出願人登録番号	591007860

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 新藤 裕一郎 SHINDO Yuichiro 3191535 日本国 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日 鉦マテリアルズ磯原工場内 c/o Isohara Factory of Nikko Materials Co., Ltd. 187-4, Usuba, Hanakawa-cho, Kitaibaraki-shi, Ibaraki 3191535 Japan 日本国 JP 日本国 JP
III-1-1	この欄に記載した者は	
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	
III-1-4ja	氏名(姓名)	
III-1-4en	Name (LAST, First):	
III-1-5ja	あて名	
III-1-5en	Address:	
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。	代理人 (agent)
IV-1-1ja	氏名(姓名)	小越 勇
IV-1-1en	Name (LAST, First):	OGOSHI Isamu
IV-1-2ja	あて名	1050002 日本国 東京都港区愛宕一丁目 2 番 2 号 虎ノ門 9 森ビル 3 階 小越国際特許事務所
IV-1-2en	Address:	OGOSHI International Patent Office Toranomom 9 Mori Bldg. 3F, 2-2, Atago 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 1050002 Japan
IV-1-3	電話番号	03-5777-1662
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-5777-1660
IV-1-6	代理人登録番号	100093296
V	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則 4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束さ れる全てのPCT締約国を指定し、取得しうる あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める 国際出願となる。	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	出願日	2003年 11月 19日 (19.11.2003)
VI-1-2	出願番号	2003-388737
VI-1-3	国名	日本国 JP
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)